

12 펄스 시리즈 브릿지 컨버터의 비대칭제어에 의한
초전도 에너지 저장장치의 P, Q 동시 제어○ 한석진, 한승연, 이승원
서울대 전기공학과The Simultaneous Control Active and Reactive Power by SMES
with Asymmetrically Controlled 12 pulse Series Bridge ConverterS. J. HAN, S. Y. HAN, S. W. RHEE
Dept. of Seoul National University

Abstract

This paper shows a asymmetrically controlled method for the simultaneous control of real and reactive power generated by Superconducting Magnetic Energy Storage (SMES).

Asymmetrically controlled 12 pulse converter has been proposed in this paper for harmonic reduction of transformer primary current.

1. 서론

초전도 에너지 저장장치 (SMES) 는 초전도체의 무저항성 및 대전류성을 이용한 에너지 저장장치로 대용량의 전기에너지를 저장 할 수 있을뿐만 아니라 효율이 90% 이상으로 높고 에너지 충전 또는 방전이 바르므로 전력계통 안정용으로 매우 유망한 장치로 평가 받고 있기 때문에 현재 광범위한 연구가 진행 중에 있으며 특히 고온 초전도체의 발전으로 그 실용화가 조속히 이루어질 전망이다. 따라서 본 논문에서는 SMES 가 전력계통에 부착되어 전력계통 안정용으로 운전될 때 계통의 유효전력, 무효전력 제어와 전원측 전류의 고조파 성분의 감소를 위한 SMES의 제어방식을 제시하였다.

SMES의 에너지 흡, 방출은 전력변환기의 접촉각을 조절함으로서 이루어 지는데 이 전력변환기의 제어방식에 따라 여러가지가 있으나 유효전력과 무효전력을 동시에 제어하는 방식으로 널리 쓰이는 방식이 3상 브릿지 컨버터를 직렬로 연결하여 사용하는

Series Bridge Converter로 이 방식은 2개의 변환기를 각각 대칭제어 함으로써 ($\alpha_1 = \alpha_2, \alpha_3 = \alpha_4$) 계통측의 고조파 성분이 13%에서 100%까지 발생하며 두개의 접촉각자가 클수록 고조파성분이 커진다. 따라서 이러한 경우에 고조파를 줄이기 위하여 변환기 1대에 대해서도 정측과 부측을 각각 비대칭제어하면 접촉각이 4개 늘어나며 이를 적절히 조합하여 고조파를 감소시킬 수 있다

2. 전력계통에서의 SMES 모델링

2.1 대칭제어 방식

6펄스 Bridge Converter 두대를 직렬로 연결한 SMES의 기본적 구성을 그림 1과 같다.

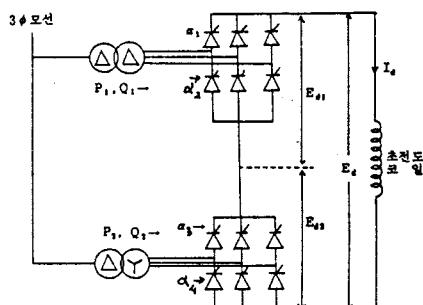


그림 1 SMES의 전력 변환기

$\Delta-\Delta$ 변환기와 $\Delta-Y$ 변환기를 각각 대칭제어 할 때는 정측 접촉각과 부측 접촉각은 같게되므로 $\alpha_1 = \alpha_2, \alpha_3 = \alpha_4$ 가된다. 전력변환기의 접촉각제어에 있어서 SMES에 인가되는 전압은 Commutation Reactance를 무시하였을 때 다음과 같이 얻어진다.

12필스 시리즈 브릿지 컨버터의 비대칭제어에 의한 초전도 에너지 저장장치의 P, Q동시제어

$$Ed1 = Edo * \cos \alpha_1 \quad \text{식 1}$$

$$Ed2 = Edo * \cos \alpha_3$$

$$Ed = Ed1 + Ed2$$

$$= Edo * (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_3) \quad \text{식 2}$$

(단 Edo : 3상 전파정류기의 무제어 출력전압)

SMES에 저장, 방출되는 유효전력과 무효전력의 식은 아래와 같다.

$$P = Ed * Id$$

$$= Edo * Id (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_3) \quad \text{식 3}$$

$$Q = Edo * Id (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_3)$$

식 3을 Edo*Id로 나누어 P, Q라고 표기하면

식 4 같이 쓸 수 있다.

$$Pn = P/Edo * Id = (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_3) \quad \text{식 4}$$

$$Qn = Q/Edo * Id = (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_3)$$

전력변환기의 사이리스터를 자연전류방식을 택했을 때 제어점호각의 범위는 Turn-off Time 및 전류리액턴스 등을 고려 하지 않았을 때 $0 < \alpha_1, \alpha_3 < 180^\circ$ 이고

이 제어 범위에서는

$$-2 < Pn < 2 \quad \text{식 5}$$

$0 < Qn < 2$ 가 된다.

즉 유효전력은 양과 음이 될 수 있으므로 흡, 방출이 가능하고 무효전력은 항상 양의 값만을 가질 수 있는데 이것은 자연전류방식을 택했기 때문이다.

식 4에서 알 수 있듯이 2개의 점호각 α_1, α_3 를 각각 제어함으로써 유효전력과 무효전력을 제어 할 수 있고 미지수가 2개, 방정식이 2개이므로 점호각을 쉽게 구할 수가 있다.

식 4에서

$$Pn = 2 * \cos((\alpha_1 + \alpha_3)/2) * \cos((\alpha_1 - \alpha_3)/2)$$

$$Qn = 2 * \sin((\alpha_1 + \alpha_3)/2) * \cos((\alpha_1 - \alpha_3)/2)$$

$$\tan((\alpha_1 + \alpha_3)/2) = Qn/Pn$$

$$\alpha_1 + \alpha_3 = 2 * \tan(Qn/Pn) \quad \text{식 6}$$

또

$$Pn + Qn = 2 + 2 * (\cos \alpha_1 * \cos \alpha_3 + \sin \alpha_1 * \sin \alpha_3)$$

$$= 2 + 2 * \cos(\alpha_1 - \alpha_3)$$

$$\alpha_1 - \alpha_3 = \cos((Pn + Qn - 2)/2) \quad \text{식 7}$$

식 6과 식 7을 연립하면

$$\alpha_1 = \tan(Qn/Pn) + 0.5 * \cos((Pn + Qn - 2)/2)$$

$$\alpha_3 = \tan(Qn/Pn) - 0.5 * \cos((Pn + Qn - 2)/2) \quad \text{식 8}$$

2.2 비대칭제어 방식

그림 1에서 $\Delta-\Delta$ 변환기의 점호는 α_1, α_2 로 $\Delta-\Upsilon$ 변환기의 점호는 α_3, α_4 로 각각 비대칭제어를 행하여 얻을 수 있는 전압 Ed는 전류리액턴스를 무시하였을 때 다음과 같이 얻어진다.

$$Ed1 = (Edo/2) * (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2)$$

$$Ed2 = (Edo/2) * (\cos \alpha_3 + \cos \alpha_4)$$

$$Ed = Ed1 + Ed2$$

$$= (Edo/2) * (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2 + \cos \alpha_3 + \cos \alpha_4) \quad \text{식 9}$$

따라서 유효, 무효전력식은

$$P = Ed * Id$$

$$= (Edo * Id/2) * (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2 + \cos \alpha_3 + \cos \alpha_4) \quad \text{식 10}$$

$$Q = (Edo * Id/2) * (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2 + \sin \alpha_3 + \sin \alpha_4)$$

$$Pn = P / Edo * Id$$

$$= (1/2) * (\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2 + \cos \alpha_3 + \cos \alpha_4) \quad \text{식 11}$$

$$Qn = Q / Edo * Id$$

$$= (1/2) * (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2 + \sin \alpha_3 + \sin \alpha_4)$$

식 11은 4개의 미지수를 가진 방정식이 2개이므로 점호각을 구하기 위해서는 변수 2개를 임의값을 취하거나 목적함수를 찾아내어 해를 구할 수 있다. 이의 자세한 내용은 다음절에서 언급한다.

식 4와 식 11은 각각 대칭제어와 비대칭제어시의 Pn, Qn식을 나타내며 두식으로부터 SMES의 유효, 무효전력의 동시제어 가능영역을 도시하면 그림 2와 같이 된다.

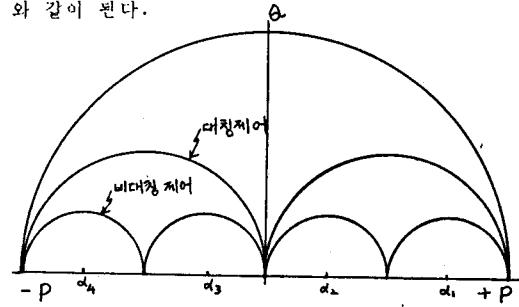


그림 2 P, Q 동시제어 가능 영역

그림 3은 대칭제어와 비대칭제어의 P, Q에 따른 벡터도이다. 이 벡터도를 보면 임의의 P, Q에 대해서 각 \theta가 정해지고 점호각 사이의 관계는 각 \theta가 관계 되지 않으므로 $\sqrt{P^2 + Q^2}$ 의 값이 같은 P, Q 값에서는 점호각이 같음을 알 수 있다.

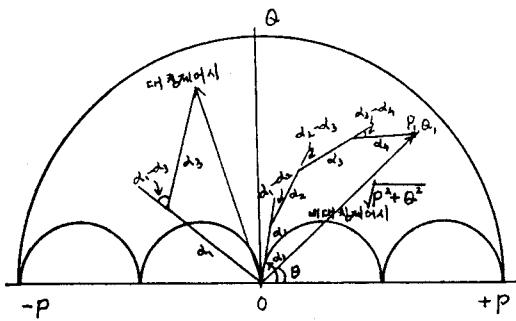
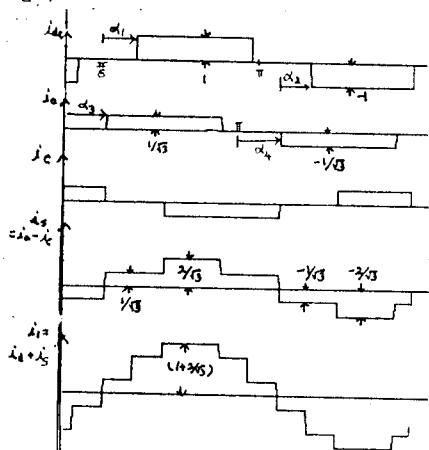


그림 3 P, Q에 따른 벡터도

3. 고조파 해석

12 펠스 Series Bridge Converter의 비 대칭 제어 시
변환기 각각의 1 차 측 전류파형을 도시하면 그림 4
과 같다.



($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 45^\circ$ 일 때)

그림 4

변환기의 전원측 선전류 파형을 접호각에 따라 Fourier Series로 전개하면

$$\text{ief } io/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (An * \cos(nt) + Bn * \sin(nt))$$

$$an = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} i(t) * \cos(nt) dt \quad \text{식 12}$$

$$bn = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} i(t) * \sin(nt) dt$$

$$io = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} i(t) dt$$

식 12에 의하여 $\Delta - \Delta$ 에 의한 전원측 선전류는

$$an = \frac{1}{\pi} (\cos(nt) dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nt) dt)$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \sin(\frac{n\pi}{3}) \cdot \cos(n(1+\frac{2\pi}{3})) - \cos(n(2+\frac{3\pi}{2}))$$

$$bn = \frac{1}{\pi} (\sin(nt) dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nt) dt)$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \sin(\frac{n\pi}{3}) \cdot \sin(n(1+\frac{2\pi}{3})) - \sin(n(2+\frac{3\pi}{2}))$$

-에 의한 전원측 선전류는

$$an = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \cos(nt) dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \cos(nt) dt$$

$$- \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \cos(nt) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \cos(nt) dt$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3} \sin(\frac{2n\pi}{3}) \cdot \sin(\frac{n\pi}{3}) [\sin(n(3+\pi)) - \sin(n(2+\pi))]$$

$$bn = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \sin(nt) dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \sin(nt) dt$$

$$- \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \sin(nt) dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \sin(nt) dt$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3} \sin(\frac{2n\pi}{3}) \cdot \sin(\frac{n\pi}{3}) [-\cos(n(3+\pi)) + \cos(n(4+2n\pi))]$$

변압기 1 차 측의 최종 전류식은 위와 두식을 더하여 구한다.

$$an = \frac{2}{\pi} \cdot \sin(\frac{n\pi}{3}) [\cos(n(1+\frac{2\pi}{3})) - \cos(n(2+\frac{3\pi}{2}))]$$

$$+ \frac{2}{\pi} \cdot \sin(\frac{2n\pi}{3}) [\sin(n(3+\pi)) - \sin(n(2+2\pi))] \quad \text{식 13}$$

$$bn = \frac{2}{\pi} \cdot \sin(\frac{n\pi}{3}) [\sin(n(1+\frac{2\pi}{3})) - \sin(n(2+\frac{3\pi}{2}))]$$

$$+ \frac{2}{\pi} \cdot \sin(\frac{2n\pi}{3}) [-\cos(n(3+\pi)) + \cos(n(4+2\pi))] \quad \text{식 13}$$

식 13으로부터 접호각에 따른 변압기 1차 측 고조파 성분을 계산할 수가 있다.

$$An = \sqrt{an^2 + bn^2}$$

$$HF30 = \sqrt{\sum_{n=1}^{30} In^2} / I_s$$

가 된다.

4. 비 대칭제어 시 접호각 결정

4.1 등차각 제어 방식

4 개의 접호각의 차이를 같게하는 방식이다
식 11은 다음과 같이 된다.

$$Pn = 0.5 * ((\cos \alpha_1) + \cos(\alpha_1 - \delta) + \cos(\alpha_1 - 2\delta) + \cos(\alpha_1 - 3\delta))$$

$$= 2 * \cos(\delta) * \cos(\delta/2) * \cos(\frac{2\alpha_1 - 3\delta}{2}) \quad \text{식 14}$$

$$Qn = 2 * \cos(\delta) * \cos(\delta/2) * \frac{(2\alpha_1 - 3\delta)}{2} \quad \text{식 15}$$

식 14와 식 15로 비 대칭 등차각제어 시의 접호각을 구할 수 있다.

그림 5는 $P = 0$ 으로하고 Q 를 변화시켜 가면서 30 고조파 까지의 Harmonic Factor HF30을 도시한 것이다

4.2 고조파 목적함수

3절에서 구한 접호각에 따른 고조파 성분식에서 우수고조파 성분을 최소화하는 식과 기수고조파를 최소화하는 식을 사용하여 P , Q 식과 함께 4 개의 식을 만들어서 4 개의 접호각을 구할 수 있다.

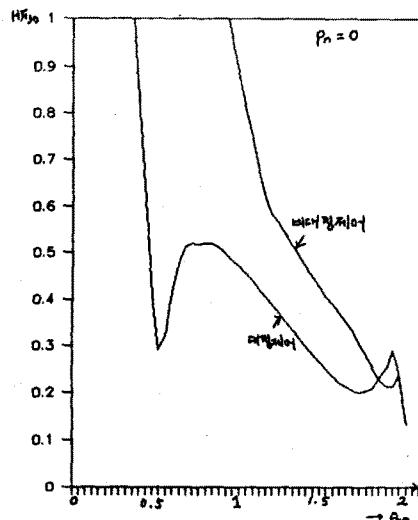


그림 5 대칭제어와의 고조파 비교

따라서 비대칭 제어시의 점호각 결정 방정식은 식 11, 식 13로 부터 아래와 같은 식이 만들어진다.

$$\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2 + \cos\alpha_3 + \cos\alpha_4 = 2P_n$$

$$\sin\alpha_1 + \sin\alpha_2 + \sin\alpha_3 + \sin\alpha_4 = 2Q_n$$

— 식 16

$$\text{Min } a_n (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) =$$

$$\text{Min } (a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \dots)$$

$$\text{Min } b_n (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) =$$

$$\text{Min } (b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + \dots)$$

식 16은 비선형방정식이므로 수치해석적인 방법을 사용하여 구할수가 있다. 그러나 이 방식은 계산시간이 많이 요구되기 때문에 SMES를 실시간제어하기 위해서는 위에서 언급한 바와같이 $\sqrt{P^2 + Q^2}$ 가 같은 값에서는 고조파성분이 같기때문에 P를 0으로 하고 Q를 변화시키면서 식16을 풀어서 고조파성분이 최소가되는 점호각을 구하면 이 점호각으로 $\sqrt{P^2 + Q^2}$ 값이 같은 다른 P, Q에서도 하모닉스는 최소가 된다.

5 결 론

본 논문에서 사용한 12 펄스 비대칭 제어방식을 사용하여 전력계통 안정용 SMES를 제어하면 계통에서 요구하는 유효, 무효전력을 만족 시킬 뿐만 아니라 하모닉스를 감소하기위한 다른 장치도없이

개봉의 하모닉스를 줄일 수 있기 때문에 경제적인 측면에서도 유용한 방식으로 생각한다.

그러나 비대칭제어의 단점은 점호 사이리스터의 점호실패를 방지하기 위하여 점호각 여유가 대칭제어시보다 좀더 늘어난다. 본 논문에서는 이와같은 점호각 안정영역을 고려하지 않았으므로 앞으로 이 방향의 연구가 필요 하다고 생각한다.

참 고 문 헌

1. EDWARD EILSON KIMBAK, "Direct Current Transmission", 1946
2. P.C. SEN, " Thyristor DC Drives", 1981
3. B.K. BOSE " Power Electronics and AC Drives", 1986
4. E. ORAN BRIGHAM, " The Fast Fourier Transform ", 1974
- 5 WILLIAM MC MURRAY, " A Study of Asymmetrical Gating for Phase Controlled Converter", IEE Vol. IA-8, No.3 1972
6. 차 귀 수, " Expansion of Power Controlled Region in SMES by Asymmetrically Controlled Pulse Converter ", 1987
7. 이 형 수, " SMES 를 이용한 P, Q 동시제어", 1987